

プログラム

発表日
発表時間

タイトル(和/英)
著者(和/英)
所属(和/英)

2015/12/03

Magnetic proximity effect to Dirac-cone states at the interface of Fe/W(110): High-resolution ARPES

13:15

S. Souma¹, K. Honma², T. Sato², Y. Tanaka², K. Sugawara¹ and T. Takahashi^{1,2}

Invite-1

*1, WPI Research Center, Advanced Institute for Materials Research, Tohoku University, Sendai 980-8577, Japan
2, Department of Physics, Tohoku University, Sendai 980-8578, Japan*

2015/12/03

軟X線角度分解光電子分光による強磁性半導体Ge_{1-x}Fe_xの電子構造の解明

13:45

坂本祥哉¹、若林勇希²、竹田幸治³、藤森伸一³、鈴木博人¹、伴芳祐²、山上浩志^{3,4}、田中雅明²、大矢忍²、藤森淳¹

口頭発表
A-1

1 東京大学理学系研究科物理学専攻、2 東京大学工学系研究科電気系工学専攻、3 日本原子力研究開発機構、4 京都産業大学理学部

2015/12/03

Induced Out-of-Plane Magnetism in Cu Layer Inserted between Co and Pt Layers Revealed by X-ray Magnetic Circular Dichroism

14:00

Jun Okabayashi¹, Tomohiro Koyama², Motohiro Suzuki³, Masahito Tsujikawa⁴, Masafumi Shirai⁴ and Daichi Chiba²

口頭発表
A-2

1. Research Center for Spectrochemistry, The University of Tokyo, 113-0033 Tokyo, Japan, 2. Department of Applied Physics, The University of Tokyo, 113-8656 Tokyo, Japan, 3. Spring-8/JASRI, Kouto, Sayo, Hyogo 679-5198, Japan, 4. Research Institute of Electrical Communication, Tohoku University, Sendai 980-8577, Japan

2015/12/03

Ag/Bi界面における逆Rashba-Edelstein効果の温度依存性

14:15

野村晶代¹、田代隆治¹、中山裕康¹、安藤和也^{1,2}

口頭発表
A-3

1 慶應義塾大学大学院理工学研究科基礎理工学専攻、2 JST PRESTO

2015/12/03

Spin Relaxation Mechanism in Ta Thin Films

14:30

Hiromu Gamou, Jeongchun Ryu, Rento Ohsugi, Makoto Kohda and Junsaku Nitta

口頭発表
A-4

Department of Materials Science, Tohoku University, Japan

プログラム

発表日
発表時間

タイトル(和/英)
著者(和/英)
所属(和/英)

2015/12/03

強磁性体の電界制御とその記録素子応用

15:00

金井 駿^{1,2}、仲谷栄伸³、岡田篤¹、佐藤英夫^{2,4}、松倉文礼^{1,2,5}、大野英男^{1,2,4,5}

Invite-2

1 東北大学電気通信研究所附属ナノ・スピントロニクス実験施設, 2 東北大学省エネルギー・スピントロニクス集積化システムセンター, 3 電気通信大学, 4 東北大学原子分子材料科学高等研究機構, 5 東北大学国際集積エレクトロニクス研究開発センター

2015/12/03

Stress-induced reversible control of the magnetic anisotropy in perpendicularly magnetized metals deposited on a flexible substrate

15:30

Shinya Ota¹, Yuki Hibino¹, Do Bang², Hiroyuki Awano², Takahiro Kozeki³, Hirokazu Akamine³, Tatsuya Fujii³, Takahiro Namazu³, Taishi Takenobu^{4,5,6}, Tomohiro Koyama¹ and Daichi Chiba¹

口頭発表

B-1

1. Department of Applied Physics, Faculty of Engineering, The University of Tokyo, Japan, 2. Toyota Technological Institute, Japan, 3. Department of Mechanical and Systems Engineering, University of Hyogo, Japan, 4. Department of Applied Physics, Waseda University, Japan, 5. Department of Advanced Science and Engineering, Waseda University, Japan, 6. Kagami Memorial Laboratory for Material Science and Technology, Waseda University, Japan

2015/12/03

Current induced spin-orbit fields in Pt/Co/AIO trilayer structures under external gate voltage

15:45

Minsik Kong, Tim Yang, Makoto Kohda and Junsaku Nitta

口頭発表

B-2

Department of Materials Science, Tohoku University, Japan

2015/12/03

Ta/CoFeB/MgO構造における磁気異方性とダンピング定数の電氣的制御

16:00

岡田篤¹、橋本祥齊¹、金井駿^{1,2}、松倉文礼^{3,1,2}、大野英男^{1,2,3,4}

口頭発表

B-3

1. 東北大学電気通信研究所附属ナノ・スピントロニクス実験施設, 2. 東北大学省エネルギー・スピントロニクス集積化システムセンター, 3. 東北大学原子分子材料科学高等研究機構, 4. 東北大学国際集積エレクトロニクス研究開発センター

2015/12/03

Magnetization Dynamics and Optical Control of Antiferromagnets

16:15

T. Satoh

Invite-3

Department of Physics, Kyushu University, Japan

プログラム

発表日
発表時間

タイトル(和/英)
著者(和/英)
所属(和/英)

2015/12/03

Design and Characterization of Broadband, Spatially-Uniform Microwave Antenna for Diamond Quantum Sensing and Imaging

16:45

佐々木健人¹、内内靖明¹、西條蒼野¹、藤田留士郎¹、渡邊幸志²、阿部英介¹、早瀬潤子¹、伊藤公平¹

口頭発表
C-1

1.慶應義塾大学大学院理工学研究科基礎理工学専攻、2.産業技術総合研究所

2015/12/03

Electric probe for spin transition and fluctuation

17:00

Zhiyong Qiu^{1,2}, Dazhi Hou^{1,2}, Ken-ichi Uchida^{3,4}, Eiji Saitoh^{1,2,3,5}

口頭発表
C-2

1.WPI Advanced Institute for Materials Research, Tohoku University, Sendai 980-8577, Japan, 2.Spin Quantum Rectification Project, ERATO, Japan Science and Technology Agency, Sendai 980-8577, Japan, 3.Institute for Materials Research, Tohoku University, Sendai 980-8577, Japan, 4.PRESTO, Japan Science and Technology Agency, Saitama 332-0012, Japan, 5.Advanced Science Research Center, Japan Atomic Energy Agency, Tokai 319-1195, Japan

2015/12/03

室温におけるY型六方晶フェライトの磁化、電気分極の相互制御

17:15

廣瀬左京¹、春木康平¹、安藤陽¹、浅香透²、木村剛³

口頭発表
C-3

1株式会社村田製作所、2名古屋工業大学大学院物質工学専攻、3大阪大学大学院基礎工学研究科

2015/12/04

Spintronics with van der Waals heterostructure of layered materials

9:15

R. Moriya¹, M. Arai¹, T. Yamaguchi¹, Y. Inoue¹, N. Yabuki¹, Y. Sata¹, S. Masubuchi¹, K. Ueno², and T. Machida^{1,3}

Invite-4

1.Institute of Industrial Science, University of Tokyo, Japan, 2.Graduate School of Science and Engineering, Saitama University, Japan, 3.Institute for Nano Quantum Information Electronics, University of Tokyo, Japan

2015/12/04

Co₂MnSi/Ag₃Mg/Co₂MnSi巨大磁気抵抗素子に関する理論研究

9:45

森川志門、辻川雅人、阿部和多加、白井正文

口頭発表
D-1

東北大学電気通信研究所

プログラム

発表日
発表時間

タイトル(和/英)
著者(和/英)
所属(和/英)

2015/12/04

Fabrication of high quality $\text{Co}_2\text{FeSi}_{0.5}\text{Al}_{0.5}/\text{CoFe}/\text{MgO}/\text{Si}$ tunnel contacts for Si-channel spin devices

10:00

T. Kondo¹, T. Akushichi¹, Y. Takamura², Y. Shuto¹, S. Sugahara¹

口頭発表
D-2

1.Imaging Sci. and Eng. Lab., Tokyo Inst. of Tech., Japan, 2.Dept. of Physical Electronics, Tokyo Inst. of Tech., Japan

2015/12/04

Coherent control of nuclear spins in GaAs using a spin injection technique

10:15

T.Uemura, T. Akiho, Y. Ebina, and M.Yamamoto

口頭発表
D-3

Graduate School of Information Science and Technology, Hokkaido University, Japan

2015/12/04

Quantum transport in topological insulator heterostructures

10:45

A. Tsukazaki¹, R. Yoshimi², K. Yasuda², M. Mogi², K.S. Takahashi³, M. Kawasaki^{2,3} and Y. Tokura^{2,3}

Invite-5

1.Institute for Materials Research, Tohoku University, Japan, 2.Department of Applied Physics and Quantum-Phase Electronics Center, University of Tokyo, Japan, 3.RIKEN Center for Emergent Matter Science, Japan

2015/12/04

量子ホールエッジ状態と結合した量子ドットにおける単一電子スピン読み出し

11:15

H. Kiyama¹, A. Oiwa¹, and S. Tarucha^{2,3}

口頭発表
E-1

1.Institute of Scientific and Industrial Research, Osaka University, Japan, 2.Department of Applied Physics, The University of Tokyo, Japan, 3.Center for Emergent Materials Science, RIKEN, Japan

2015/12/04

MBE growth and magnetic properties of (Sn,Mn)Te thin films

11:30

R. Sakurai¹, T. Yamaguchi¹, R. Ishikawa¹, R. Akiyama², S. Kuroda¹, A. Kimura³, K. Takeda⁴, Y. Saitoh⁴

口頭発表
E-2

1.Inst. Mater. Sci., Univ. Tsukuba, 2.Dept. Phys., Univ. Tokyo, 3.Dept. Phys., Hiroshima Univ., 4.Japan Atomic Energy Agency

プログラム

発表日
発表時間

タイトル(和/英)
著者(和/英)
所属(和/英)

2015/12/04

High efficient gate control of spin signals in GaAs

11:45

T. Miyakawa, T. Akiho, Y. Ebina, M. Yamamoto, T. Uemura.

口頭発表
E-3

Graduate School of Information Science and Technology, Hokkaido University

2015/12/04

Spin to charge conversion in metal/semiconductor single-walled carbon nanotubes

13:30

Ei Shigematsu^{1,*}, Hiroshi Nagano^{1,*}, Sergey Dushenko¹, Yuichiro Ando¹, Tetsuya Tsuda², Susumu Kuwabata², Taishi Takenobu³, Takeshi Tanaka⁴, Hiromichi Kataura⁴, Teruya Shinjo¹ and Masashi Shiraishi¹

口頭発表
F-1

1. Department of Electronic Science and Engineering, Kyoto University, Kyoto 615-8510, Japan, 2. Graduate School of Engineering Science, Osaka University, Toyonaka 560-8531, Japan, 3. Graduate School of Engineering, Osaka University, Suita 565-0871, Japan, 4. School of Advanced Science and Engineering, Waseda University, Tokyo 169-8555, Japan 5. Nanomaterials Research Institute, AIST, 305-8562, Japan

2015/12/04

Transient analysis of oblique Hanle signals observed in GaAs based on a time evolution of nuclear spin temperature

13:45

Zhichao Lin, Mahmoud Rasly, Masafumi Yamamoto, and Tetsuya Uemura

口頭発表
F-2

Graduate School of Information Science and Technology, Hokkaido University, Sapporo, Japan

2015/12/04

Gate-controlled spin-orbit interaction for suppression of spin relaxation in an InGaAs quantum well

14:00

K. Yoshizumi, M. Kohda and J. Nitta

口頭発表
F-3

Department of Materials Science, School of Engineering, Tohoku University, Japan

2015/12/04

異なる電極形状によるInAs自己形成量子ドットの電気伝導特性

14:15

R. Shikishima¹, A. Oiwa¹, H. Kiyama¹, S. Baba², T. Hirayama¹, N. Nagai³, K. Hirakawa³, and S. Tarucha^{2,4}

口頭発表
F-4

1. Institute of Scientific and Industrial Research, Osaka University, Japan, 2. Department of Applied Physics, The University of Tokyo, Japan, 3. Institute of Industrial Science, The University of Tokyo, Japan, 4. Center for Emergent Materials Science, RIKEN, Japan

プログラム

発表日
発表時間

タイトル(和/英)
著者(和/英)
所属(和/英)

2015/12/04

High-temperature ferromagnetism in heavily Fe-doped ferromagnetic semiconductor (Ga,Fe)Sb

14:30

Nguyen Thanh Tu¹ Pham Nam Hai^{1,2} Le Duc Anh¹ and Masaaki Tanaka¹

口頭発表
F-5

1.Department of Electrical Engineering & Information Systems, The University of Tokyo., 2.Department of Physical Electronics, Tokyo Institute of Technology

2015/12/04

金属/絶縁体界面におけるスピンの生成現象の時間分解測定

15:00

立野裕真¹, 安藤和也^{1,2}

口頭発表
G-1

1.慶應義塾大学大学院理工学研究科基礎理工学専攻、2.科学技術振興機構さきがけ

2015/12/04

GaAs/AlGaAs 二次元電子系への動力学的スピン注入の研究

15:15

K. Ohtomo¹, Y. Ando¹, T. Shinjo¹, T. Uemura², and M. Shiraishi¹

口頭発表
G-2

1.Department of Electronic Science and Engineering, Kyoto University, Japan, 2.Graduate School of Information Science and Technology, Hokkaido University, Japan

2015/12/04

Magnetization switching in Ta/CoFeB/MgO nanodot driven by spin-orbit torque

15:30

C. Zhang¹, S. Fukami^{2,3}, H. Sato^{2,3}, F. Matsukura^{1,2,4}, and H. Ohno^{1,2,3,4}

口頭発表
G-3

1.Laboratory for Nanoelectronics and Spintronics, RIEC, Tohoku Univ., Japan, 2.CSIS, Tohoku Univ., Japan, 3.CIES, Tohoku Univ., Japan, 4.WPI-AIMR, Tohoku Univ., Japan

2015/12/04

CoFeB/MgO 垂直磁化容易磁気トンネル接合における電界誘起非線形強磁性共鳴

15:45

平山絵里子¹, 金井駿^{1,2}, 大江純一郎³, 佐藤英夫^{2,4}, 松倉文礼^{1,2,5}, 大野英男^{1,2,4,5}

口頭発表
G-4

1.東北大学電気通信研究所附属ナノ・スピン実験施設、2.東北大学省エネルギー・スピントロニクス集積化システムセンター、3.東邦大学理学部物理学科、4.東北大学国際集積エレクトロニクス研究開発センター、5.東北大学原子分子材料科学高等研究機構

プログラム

発表日
発表時間

タイトル(和/英)
著者(和/英)
所属(和/英)

2015/12/04

Electromagnetic effect driven by the magnetization dynamics

16:00

Jun-ichiro Ohe

Invite-6

Department of Physics, Toho University, Japan, JST, CREST, Japa
